



三洋半導体  
ニュース

No 1401  
8043

2SC3486

シリコン NPN 高集積度アレーナ型トランジスタ

高精細度CRTディスプレイ水平偏向出力用

- 特長
- ・高耐圧、高信頼性である。
  - ・スイッチングスピードが速い:  $t_f = 0.3 \mu s \text{ max.}$
  - ・一点止め樹脂モールドパッケージで 取り付け作業性が良い。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a = 25^\circ C$

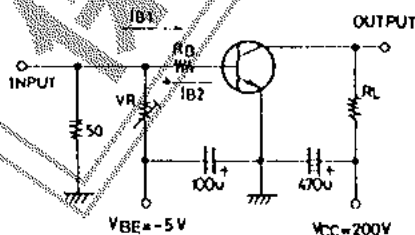
			unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	800	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	7	V
コレクタ電流	$I_C$	6	A
ピークコレクタ電流	$i_{cP}$	16	A
コレクタ損失	$P_C$	120	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a = 25^\circ C$

			min	typ	max	unit
コレクタ・シャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 800V, I_E = 0$			10	$\mu A$
エミッタ・シャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$			1	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 1A$	8			
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = 10V, I_C = 1A$		3		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5A, I_B = 1.2A$			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 5A, I_B = 1.2A$			1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C = 5mA, I_E = 0$	1500			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = 5mA, R_{BE} = \infty$	800			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = 5mA, I_C = 0$	7			V
蓄積時間	$t_{stg}$	$I_C = 5A, I_B1 = 1A,$ $I_B2 = -2A,$ $R_L = 40\Omega$			3.0	$\mu s$
下降時間	$t_f$				0.3	$\mu s$

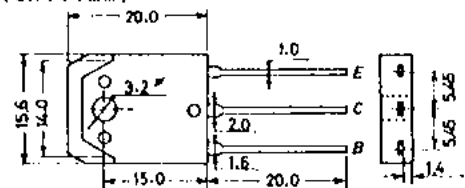
スイッチングタイム測定回路

$PW = 20 \mu s, \text{Duty} \leq 1\%$



外形図 2022

(unit: mm)



E: Emitter  
C: Collector  
B: Base

※ これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370 05 群馬県大泉町坂田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

TEL. 0276 63 2111 (大代表)

B043Y0 X-6234 No1401-1/3